

反応性イオンエッチング装置



反応性イオンエッチング装置
サムコ(株)
RIE-400iPB-YK

平成23年度導入

【主な用途・仕様】

シリコン (Si), SiO₂ の垂直エッチング

- ・ 試料サイズ：φ4 インチ以下
- ・ エッチング速度：10 μm / min (Si), 500nm / min (SiO₂)
- ・ ビーム解像度：100nm (ビーム径<100nm)
- ・ マスク選択比：100：1 (Si：ポジ型 PR, SiO₂：Ni)

【担当部署】 電子情報システム部：MEMS グループ

【設備使用の項目・使用料】

【受託試験の項目・手数料】 マイクロマシニング加工 (C)